

	<h2>SIHH21N65E-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHH21N65E-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 20.3A PWRPAK8X8</p> <p>Datenblätter:  SIHH21N65E-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




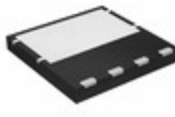

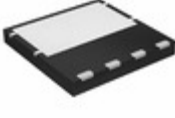


Spezifikationen

Teilenummer	SIHH21N65E-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 20.3A PWRPAK8X8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2404pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	99nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.3A (Tc)

SIHH21N65E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHH21N65E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHH21N65E-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHH21N65E-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHH21N65EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 19.8A POWERPAK</p>	 <p>SIHH24N65EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 650V 23A POWERPAK</p>	 <p>SIHH24N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 650V 23A POWERPAK</p>	 <p>SIHH21N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 20A POWERPAK8X8</p>
 <p>SIHH21N65EF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 19.8A POWERPAK</p>	 <p>SIHH24N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 650V 23A POWERPAK</p>	 <p>SIHH21N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 20.3A PWRPAK8X8</p>	 <p>SIHH21N60EF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 600V 19A POWERPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHH21N65E-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIHH21N65E-T1-GE3 Datenblatt	SIHH21N65E-T1-GE3-Datenblätter	SIHH21N65E-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHH21N65E-T1-GE3
SIHH21N65E-T1-GE3 Electronic	SIHH21N65E-T1-GE3-Komponenten	SIHH21N65E-T1-GE3-Verteiler	SIHH21N65E-T1-GE3-Bild	SIHH21N65E-T1-GE3-Teil
SIHH21N65E-T1-GE3 Preis	SIHH21N65E-T1-GE3 Hersteller	SIHH21N65E-T1-GE3 Bild	SIHH21N65E-T1-GE3 Aktie	SIHH21N65E-T1-GE3 Inventar
SIHH21N65E-T1-GE3 Neu	SIHH21N65E-T1-GE3 Original	SIHH21N65E-T1-GE3 garantiert	SIHH21N65E-T1-GE3 RFQ	SIHH21N65E-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited